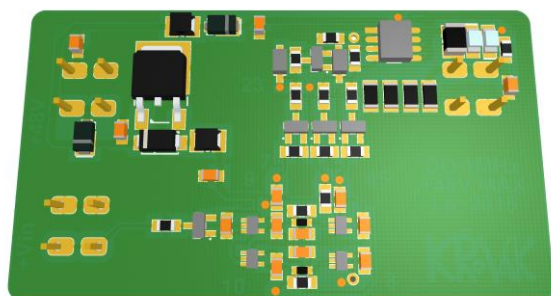
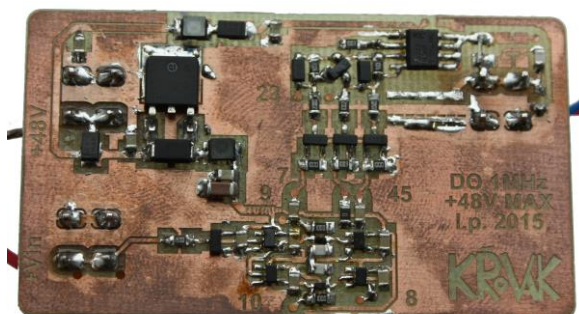


# Funkční vzorek

## High-speed P-MOSFET driver



- ▶ V souladu s definicí uvedenou v dokumentu Úřadu vlády ČR, č.j.: 1417/2013-RVV „Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015 je uplatňován funkční vzorek „High-speed PMOSFET driver“.
- ▶ Funkční vzorek vznikl v přímé souvislosti s řešením grantu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, SGS-2015-002: Moderní metody řešení, návrhu a aplikace elektronických a komunikačních systémů.
- ▶ Tento modul slouží jako budič P-MOSFET tranzistoru zapojený jako horní sériový spínač s maximálním rozsahem napájecího napětí 50 V a zatížením 2 A. Maximální spínací frekvence je 1 MHz a doba zpoždění signálu 84 ns. Vstupní signál musí splňovat parametry 5V CMOS logiky.
- ▶ Detailní informace jsou součástí technické dokumentace TD-22110-FV003-2015

### EVIDENČNÍ ČÍSLO:

22110 – FV003 – 2015

### KONTAKTNÍ OSOBA:

Ing. Jindřich Křivka

tel.: 37763 4224

jkrivka@kae.zcu.cz

### ŘEŠITELSKÉ

### PRACOVISTĚ:

Západočeská univerzita v Plzni

Fakulta elektrotechnická

Katedra aplikované elektroniky a  
telekomunikací

Univerzitní 8, 306 14 Plzeň